半球状の凸底面を有する垂直円柱まわりの膜沸騰熱伝達の実験

山田たかし*・豊田 香**・茂地 徹* 桃木 悟** ・金丸邦康*・山口朝彦*

Experiments on Film Boiling Heat Transfer around a Vertical Cylinder with a Convex Hemispherical Bottom

by

Takashi YAMADA*, Kaoru TOYODA**, Toru SHIGECHI* Satoru MOMOKI **, Kuniyasu KANEMARU* and Tomohiko YAMAGUCHI*

The film boiling heat transfer around a vertical silver cylinder with a convex hemispherical bottom was investigated experimentally for quiescent water at atmosphereric pressure. The experiments have been carried out by a transient method, i.e., quenching method. The diameter of test cylinder is 32mm and the length is 48mm. The test cylinder was heated to about 600°C in an electric furnace and then cooled in saturated and subcooled water with the immersion depth of about 100mm. The degree of liquid subcooling was varied from 0 to 35K. The film boiling heat transfer increased in terms of heat flux by 225% with an increase in 30K liquid subcooling at the wall superheating of 300K. The wall superheating and heat flux at the lower limit of film boiling increased with an increase in liquid subcooling.

Key Words : Film Boiling, Vertical Cylinder, Convex Hemispherical Bottom, Heat Transfer

1. まえがき

3次元物体まわりの膜沸騰は金属の焼入れ,材料の 製造工程,原子炉の炉芯の緊急冷却等で生じる.液体 中で冷却される3次元物体まわりの膜沸騰に関して, 現象の観察や実験データの蓄積は伝熱のメカニズムを 研究し熱伝達特性を予測するために不可欠である.著 者らはこれまでに大気圧下のイオン交換水を用いた飽 和状態およびサブクール状態で,円柱底面が水平な有 限垂直円柱まわりの膜沸騰現象の観察と実験データの 蓄積を行い,膜沸騰熱伝達に対して±15%以内で相関 できる伝熱整理式を作成している^{1,2}).

本研究では、半球状の凸底面を有する場合の垂直円 柱まわりの飽和並びにサブクール膜沸騰熱伝達特性に 関して実用的な伝熱整理式を作成することを目的とし て、垂直円柱まわりの詳細な現象観察を行い、冷却曲 線と沸騰曲線を実測し、確定したのでその結果につい て報告する.また、膜沸騰領域と遷移沸騰領域の境界 点(膜沸騰下限界点)における過熱度と熱流束の測定値 についても報告する.

2. 実験装置および実験方法

Fig.1は本研究で使用した実験装置の概略図で ある.装置は沸騰槽,供試円柱加熱装置,昇降 装置,温度測定装置および沸騰現象観察装置か ら構成されている.沸騰槽はステンレス製で, 450mm(L)×450mm(W)×750mm(H)の大きさを有す る直方体の容器である.沸騰槽の側面および底面の それぞれの中央部に沸騰現象の目視観察や写真お よびビデオ撮影ができるように4つの観察窓が設け られている.沸騰槽の底面のコーナー付近にバル ク水(大気圧下のイオン交換水)昇温用として、2kW 容量の浸漬型加熱器を2個設置している.この加 熱器で発生する気泡が供試円柱周囲のバルク水を 乱さないように、沸騰槽の内側に透明なガラス箱 [300mm(L)×300mm(W)×600mm(H)]を設けて二重水 槽にしている.実験中のバルク水の温度は温度制御装 置によって一定に保たれている.

Fig.2は本実験で使用した供試円柱の断面図を示したもので, Dは円柱の直径(D=32mm), Lは円柱の長さ(L=48mm)である.この供試体は円柱の先端を半球

平成 18年 12月15日 受理

^{*}機械システム工学科(Department of Mechanical Systems Engineering)

^{**}生產科学研究科(Graduate School of Science and Technology)

状に加工したものであり,供試円柱には酸化防止と高 熱伝導率(常温にて約410[W/(m·K)])の観点から純度 99.99%の銀を使用した.供試円柱の冷却時の温度履歴 は,円柱の中心部に円柱上面より32mmの位置まで挿 入されているシース径1mmのK型熱電対で測定され る.円柱の温度は横河・ヒューレット・パッカード(株) 製のデータ集録/制御ユニット(YHP3852A)により0.25 秒のサンプリング間隔で計測される.

実験前の表面条件を一定にするために供試円柱表面 に金属研磨材を塗り、バフ研磨にて鏡面仕上げし、ア ルコールで洗浄した.供試円柱は垂直の姿勢で電気炉 によって約600℃まで加熱された後、昇降装置を介し て静止した大気圧下のバルク水の水面下約100mmの 深さまで静かに浸漬され冷却される.なお、冷却中の 円柱まわりの沸騰の様相を目視、高速ビデオおよび写 真撮影により観察した.

3. 伝熱面温度と熱流束の測定

供試円柱の材質には熱伝導率の高い銀を使用してい るので,円柱の温度は集中定数系,つまり,空間的に 一様に冷えていくと仮定する.従って,伝熱体の中心 温度は伝熱体の表面温度と等しく,全表面平均の熱流 束*q*は次式によって与えられる.

$$q = -\rho c \frac{V}{A} \frac{dT}{d\tau} \tag{1}$$



1. Test cylinder 2. Boiling bath 3.Lifting device 4. Temperature controller 5. Power controller 6. Heater 7. Glass box 8. K-type thermocouple 9. K-type thermocouple 10. Data acquisition/control unit 11. Electric furnace 12. Video camera 13. Video cassette recorder 14. Digital AV mixer 15. Video monitor

Fig.1 Schematic of experimental apparatus



Fig.2 Test cylinder

ここに,Aは供試円柱の全伝熱面積,Vは体積で次式 で与えられる.

$$A = \frac{3}{4}\pi D^2 + \pi D(L - D/2)$$
(2)

$$V = \frac{1}{12}\pi D^2 \left[3(L - D/2) + D \right]$$
(3)

なお, cは比熱(=234.5J/(kg·K)), dT/drは冷却速度, ρ は密度(=10490kg/m³)である.本実験で採用した銀製 の円柱の場合には, 膜沸騰時のビオー数が飽和膜沸騰 では0.02以下, サブクール膜沸騰では0.04以下と評 価できるので, 集中定数系の仮定は妥当なものである と考える.

本研究では膜沸騰下限界点を冷却速度 $dT/d\tau$ が最小 となる点と定め、そのときの過熱度 ΔT_{\min} と熱流束 q_{\min} をそれぞれ次式のように評価する.

$$\Delta T_{\min} = (T - T_{\text{sat}}) \Big|_{\frac{dT}{d\tau}}\Big|_{\min}$$
(4)

$$q_{\min} = -\rho c \frac{V}{A} \frac{dT}{d\tau} \bigg|_{\min}$$
(5)

ここに,*T*は円柱温度,*T*_{sat}はバルク水の飽和温度である.

4. 膜沸騰の様相

1/8000秒・絞りF5.6で撮影した半球状の凸底面を有 する垂直円柱に形成される蒸気膜の生成から崩壊まで の挙動観察の一例をFig.3およびFig.4に示す.Fig.3お よびFig.4にパラメータとして示す τ は冷却経過時間, ΔT_{sat} は伝熱面過熱度(円柱温度-バルク水の飽和温 度)である.また, ΔT_{sub} は液体サブクール度(バルク 水の飽和温度-バルク水温度)である.本節で用いて いる語句において,「乱れ」とは円柱表面に形成される 蒸気膜内が不規則に激しく混合し気液界面が撹乱して いるさまを,「波状」とは気液界面上に一定の間隔で環 状のしわが存在するさまを表している.

Fig.3はバルク水が飽和水($\Delta T_{sub}=0K$)の場合, Fig.4はバルク水がサブクール水($\Delta T_{sub}=20K$)の場合 であり、これら一連の写真観察結果から以下のことが 明らかになった。Fig.3に示すバルク水が飽和水の場 合、水面下約100mmの位置に固定された浸漬直後の 円柱は激しい沸騰のため円柱全面を覆う蒸気膜は厚く 不安定で乱れており、Fig.3(a)のような状態は約25秒 程度持続する。その後、安定で平滑な界面を有する蒸 気膜に移行する。半球状の凸底面下で発生する蒸気は 垂直側面に沿って上昇する。一方、円柱上面では柱状 または茸状の蒸気溜が形成され、それぞれの蒸気溜か



(a) $\tau = 0 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 490 \text{K}$



(d) $\tau = 80 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 170 \text{K}$



(b) τ =30sec, $\Delta T_{sat}\approx$ 340K



(e) $\tau = 95 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 135 \text{K}$



(c) $\tau = 50 \text{sec}, \, \Delta T_{\text{sat}} \approx 265 \text{K}$



(f) $\tau = 100 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 125 \text{K}$





(a) $\tau = 0 \sec \Delta T_{sat} \approx 485 \mathrm{K}$



(d) $\tau = 26 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 260 \text{K}$



(b) $\tau = 8 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 410 \text{K}$



(e) $\tau = 30 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 235 \text{K}$



(c) $\tau = 16 \text{sec}, \Delta T_{\text{sat}} \approx 340 \text{K}$



(f) τ =32sec, $\Delta T_{sat}\approx$ 220K

Fig.4 Photographs of film boiling around a vertical cylinder with a convex hemispherical bottom at $\Delta T_{\rm sub}$ =20K

ら気泡が交互に離脱し、その後には新しい蒸気溜が形 成される. Fig.3(b)および Fig.3(c)で観察されるよう に、浸漬して30秒から50秒経過すると半球状の凸底 面の蒸気膜はほぼ平滑な気液界面に移行する. 円柱側 面および円柱上面の気液界面の乱れは弱くなり安定し た蒸気膜に覆われている.浸漬後80秒から95秒経過 した沸騰の様相は, Fig.3(d) および Fig.3(e) で観察さ れるように, 半球状の凸底面は平滑な界面状態となり 安定した薄い蒸気膜で覆われている. 半球状の凸底面 から接続される円柱側面の垂直部分の下端側は平滑な 界面状態,円柱側面の上端側は波状性の界面状態に なっている.一方,円柱上面の気液界面は安定した 蒸気膜に覆われているが,弱い乱れが存続している. Fig.3(f)は浸漬後100秒の蒸気膜崩壊後の遷移沸騰状態 の様相でその後,核沸騰へ移行していく.蒸気膜の崩 壊はFig.3(e)とFig.3(f)の間で発生し、膜沸騰下限界 点に密接に関係すると考えられる蒸気膜崩壊の起点 は、写真観察では捉えられていないが目視観察による と半球状の凸底面の場合は垂直円柱上端部の角の部分 で,先の研究¹⁾において使用した円柱底面が水平な場 合には伝熱面上で蒸気膜の厚さが最も薄くなる円柱底 面端部の角の部分であり,円柱底面の形状によって顕 著な相違が認められた.しかし,両者とも蒸気膜の崩 壊は円柱全面に斉時的に伝播する.

一方,バルク水が80℃のサブクール水の場合, Fig.4(a)の観察より明らかなように,水面下約100mm の位置に固定された直後でも円柱まわりの沸騰の様相 はFig.3(a)に比べて穏やかであり,円柱全面に形成さ れる蒸気膜の界面の乱れは少なく,半球状の凸底面お よびそれに接続される円柱側面の垂直部分の下端側は 平滑な界面状態にあり,安定した薄い蒸気膜で覆われ ている.円柱側面の垂直部分の上端側は安定した薄い 蒸気膜で覆われているが,界面は波状になっている. 円柱上面も安定した薄い蒸気膜で覆われているが,界 面からは小さな気泡が離脱し僅かながら乱れがある. 円柱上面から離脱した上昇気泡はバルク水の温度が低 いほど早く消滅する.浸漬後8秒から26秒に至る沸騰 の様相[Fig.4(b)からFig.4(d)]に大きな変化は見られ ず、半球状の凸底面および円柱側面の垂直部分は安定 で薄い蒸気膜で覆われ概ね平滑な界面状態にある.円 柱上面の気液界面は僅かではあるが乱れが生じてい る. Fig.4(e)は浸漬後30秒の沸騰の様相で垂直円柱上 端部の角の部分から蒸気膜の崩壊が始まった瞬間を捉 えたものであり、Fig.4(f)は円柱全面の蒸気膜が崩壊 した後の遷移沸騰状態の様相でその後,核沸騰へ移行 する. Fig.4(b)から Fig.4(e)で見られるような円柱の 垂直面の蒸気膜表面に発生している環状のしわは一定 の間隔を保って存在しており, 垂直面上を上昇してい る.この現象は伝熱面過熱度が低くなるほど、すなわ ち、垂直面を覆っている蒸気膜が薄くなるほど顕著で あり,底面が水平な円柱^{1,2)}の場合でも観察されてい る. 半球状の凸底面の場合の蒸気膜崩壊の起点は, 飽 和の条件下と同じように垂直円柱上端部の角の部分 [Fig.4(e)参照]であるが,一方円柱底面が水平な場合²⁾ には円柱底面端部の角の部分であり、サブクールの条 件下でも円柱底面の形状によって起点の相違が認めら れた.しかし,蒸気膜の崩壊は飽和の条件下と同じよ うに両者とも円柱全面に斉時的に伝播する.

結果と考察

5.1 冷却曲線および冷却速度曲線

Fig.5は供試円柱を大気圧下で飽和水中およびサ ブクール水中へ浸漬冷却した場合の円柱の中心部 の温度と冷却時間の関係を示した冷却曲線(太線)と 冷却速度曲線(細線)の実測値の一例で,Fig.5(a)は $\Delta T_{sub}=0K(バルク水温度100℃)の場合,Fig.5(b)は$ $<math>\Delta T_{sub}=10K(バルク水温度90℃)の場合,Fig.5(c)は$ $<math>\Delta T_{sub}=20K(バルク水温度80℃)の場合を示している.$



Fig.5 Cooling curve and cooling rate

図中の各曲線上には \bullet 印の記号が付されているが,こ れは冷却速度が最小となる点で3節で述べたように本 研究ではこの点を膜沸騰の下限界と定義している.こ れらの図より、 \bullet 印で示す下限界点の時刻での円柱温 度と冷却速度は液体サブクール度 ΔT_{sub} が大きくなる ほど高くなっていことがわかる.

Fig.6は座標の縦軸を無次元温度 $(T-T_{\infty})/(T_i-T_{\infty})$ で表わした冷却曲線で,座標の横軸は冷却時間 τ [s]である.ここに,Tは円柱温度,T_iは測定開始時の円柱 温度,T_∞は大気圧下のバルク水温度である.図中の 各冷却曲線上の●印の記号は膜沸騰の下限界点を示し ており,各冷却曲線は供試円柱の温度がバルク水温度 に到達するまでを描いている.本研究は膜沸騰領域を 対象としているので,次節に示す沸騰曲線の考察には 供試円柱の冷却開始($\tau=0$)から●印の記号で示した下 限界点までのデータを使用する.

5.2 膜沸騰領域の沸騰曲線

Fig.7は膜沸騰領域の沸騰曲線を、液体サブクール 度 $\Delta T_{sub}=0K$, 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, 30Kおよび 35Kをパラメータとして示したもので、Fig.6に示し た冷却曲線のデータをもとに式(1)より求めたもの である.この図より,熱流束gは液体サブクール度 $\Delta T_{\rm sub}$ が大きくなるに従って高くなるとともに \bullet 印の 記号で示した膜沸騰の下限界点での熱流束が高過熱度 側へ移動しており,遷移沸騰領域への移行は高い熱流 束で生じることがわかる.サブクール膜沸騰熱伝達を 評価する上で基準となる飽和膜沸騰熱伝達における 熱流束は、450Kの高過熱度から200Kの低過熱度にお いて約80kW/m²から43kW/m²の値をとり、サブクー ルされた膜沸騰領域の熱流束は飽和状態の熱流束よ り,過熱度 ΔT_{sat} =300Kに対して ΔT_{sub} =5Kの場合に は約25%、 ΔT_{sub} =10Kの場合には約55%、 ΔT_{sub} =20K の場合には約100%、 $\Delta T_{sub}=30K$ の場合には約225%、 $\Delta T_{sub}=35K$ の場合には約235%増大し、液体サブクー ル度が膜沸騰熱伝達に強く影響していることがわか る.

5.3 膜沸騰領域の熱伝達係数

Fig.8は伝熱面過熱度 ΔT_{sat} =200K, 250K, 300K, 350 K, 400Kおよび450Kでの膜沸騰領域における平均熱伝 達係数hと液体サブクール度 ΔT_{sub} との関係について 示したものである.平均熱伝達係数hは熱流束qを伝 熱面過熱度 ΔT_{sat} で除すことでFig.7に示す沸騰曲線の データより算出することができる.ここに示す値は伝 熱面過熱度 ΔT_{sat} =200K, 250K, 300K, 350K, 400Kお よび450Kに対するもので,この図より,平均熱伝達 係数hは液体サブクール度 ΔT_{sub} が大きくなると増大



Fig.8 Relationship between h and $\Delta T_{\rm sat}$

し、伝熱面過熱度 ΔT_{sat} が大きくなると低下すること がわかる.サブクール膜沸騰熱伝達を評価する上で基 準となる飽和膜沸騰熱伝達における平均熱伝達係数 は、450Kの高過熱度から200Kの低過熱度において約 180W/(m²·K)から215W/(m²·K)の値をとり、サブクー ルされた膜沸騰領域の平均熱伝達係数は、熱流束と同 様に伝熱面過熱度 ΔT_{sat} =300Kにおいて飽和の場合よ り25%から235%程度増大し、液体サブクール度が膜 沸騰領域の熱伝達係数に強く影響していることがわか る.

5.4 膜沸騰下限界点における伝熱面過熱度

Fig.9はFig.7に示した沸騰曲線上の・印点(膜沸騰 下限界点)の過熱度 ΔT_{min} を縦軸に,液体サブクール 度 ΔT_{sub} を横軸にとり測定値を整理したものである. Fig.9に示すように,本実験範囲の・印で示す測定値 の ΔT_{min} は液体サブクール度に強く依存し,液体サブ クール度が大きくなるに従って増大している.実線は これらの測定値を最小二乗法で補間した1次曲線[式 (6)]より計算された値であり,膜沸騰下限界点におけ る過熱度 ΔT_{min} の測定値を±5%程度で整理できる.

$$\Delta T_{\min} = 133 + 4.65 \Delta T_{\text{sub}} \text{ [K]}$$

式(6)より明らかなように、半球底面を有する垂直円 柱の場合の飽和における膜沸騰下限界点における過熱 度は133Kであるが、水平底面を有する垂直円柱の場 合¹⁾には136Kで、飽和における膜沸騰下限界点の過 熱度は半球底面を有する垂直円柱の方が水平底面を有 する垂直円柱の場合より低い結果となっている.

5.5 膜沸騰下限界点における熱流束

Fig.10はFig.7に示した沸騰曲線上の・印点(膜沸 騰下限界点)の熱流束 q_{\min} を縦軸に,液体サブクール 度 ΔT_{sub} を横軸にとり測定値を整理したものである. Fig.10に示すように,本実験範囲の・印で示す測定値 $o q_{\min}$ は液体サブクール度に強く依存し,液体サブ クール度が大きくなるに従って増大している.実線は これらの測定値を最小二乗法で補間した1次曲線[式 (7)]より計算された値であり,膜沸騰下限界点におけ る熱流束 q_{\min} の測定値を±5%程度で整理できる.

$$q_{\min} = 34 + 3.08 \Delta T_{\rm sub} \, [\rm kW/m^2]$$
 (7)

式(7)より明らかなように、半球底面を有する垂直円 柱の場合の飽和における膜沸騰下限界点における熱流 束は34kW/m²であるが、水平底面を有する垂直円柱 の場合¹⁾にはアスペクト比(円柱長さ/円柱直径) =1近 傍では30kW/m²で、飽和における膜沸騰下限界点の 熱流束は半球底面を有する垂直円柱の方が水平底面を 有する垂直円柱の場合より高い結果となっている.

6. 結論

半球状の凸底面を有する銀製の供試円柱を垂直の姿 勢で大気圧下の静止した飽和およびサブクールの水中 に浸漬して冷却した際の膜沸騰熱伝達に関して実験を 行い,本実験範囲で以下のことが明らかになった. (1)飽和膜沸騰領域の熱流束は高過熱度から低過熱度 に向けて約80kW/m²から43kW/m²の大きさである. (2)飽和膜沸騰領域の熱伝達係数は高過熱度から低過



Fig.9 Relationship between ΔT_{\min} and ΔT_{\sup}



Fig.10 Relationship between $q_{\rm min}$ and $\Delta T_{\rm sub}$

熱度に向けて約180W/(m²·K)から215W/(m²·K)の大 きさである.

(3) 膜沸騰領域の熱流束は液体サブクール度が高くなる程増大し,液体サブクール度の大きさによって伝熱 面過熱度300Kで25%から235%程度の増加が得られた.

(4) 膜沸騰領域の平均熱伝達係数は液体サブクール度 が高くなる程増大し,伝熱面過熱度が大きくなると低 下する.

(5) 膜沸騰の下限界点は液体サブクール度が高くなる 程,高過熱度側に移動し,遷移沸騰領域への移行は高 い熱流束で生じる.

(6) 膜沸騰下限界点の過熱度および熱流束の測定値を ±5%程度で,液体サブクール度に対する1次の補間式 で相関できる.

参考文献

1) 山田 他5名; 有限長の垂直円柱まわりの膜沸騰熱伝達, 日本機械学会論文集(B編), **70**, 695, (2004), 1762-1768.

2) 山田 他5名; 有限垂直円柱まわりのサブクール膜沸 騰熱伝達に関する研究(第2報: 伝熱整理式の改良), 長 崎大学工学部研究報告, **36**, 66, (2006), 23-32., 有限垂 直円柱まわりのサブクール膜沸騰熱伝達, 日本機械学 会2006年度年次大会講演論文集(3), 149-150.